

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 50033/107—96

半导体分立器件
2EY621、2EY622、2EY623 型体
效应二极管详细规范

Semiconductor discrete device

Detail specification for Gunn diodes for type

2EY621, 2EY622, 2EY623

1996-08-30 发布

1997-01-01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

半导体分立器件
2EY621、2EY622、2EY623 型体效应二极管
详细规范

SJ 50033/107—96

Semiconductor discrete device

Detail specification for Gunn diodes for type 2EY621, 2EY622, 2EY623

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 2EY621、2EY622、2EY623 型体效应二极管(以下简称器件)的详细要求。

1.2 适用范围

本规范适用于器件的研制、生产和采购。

1.3 分类

本规范根据器件质量保证等级进行分类。

1.3.1 器件的等级

按 GJB 33—85《半导体分立器件总规范》1.3 条的规定,提供的质量保证等级为普军级、特军级、超特军级、分别用 GP、GT、GCT 表示。

2 引用文件

- GB 6570—86 微波二级管测试方法
GJB 33—85 半导体分立器件总规范
GJB 128—86 半导体分立器件试验方法

3 要求

3.1 详细要求

各项要求应符合 GJB 33 和本规范的规定。

3.2 设计、结构和外形尺寸

器件的设计、结构和外形尺寸应按 GJB 33 和本规范的规定。

3.2.1 引出端材料和涂层

引出端材料应为铜,表面涂层应为金。

3.2.2 器件结构

本器件采用 $n^+ - n - n^+$ 砷化镓外延材料,电镀热沉,台式结构,同轴管壳封装。

3.2.3 外形尺寸

外形尺寸按 GJB 1557 的 W10-01 型, 如图。

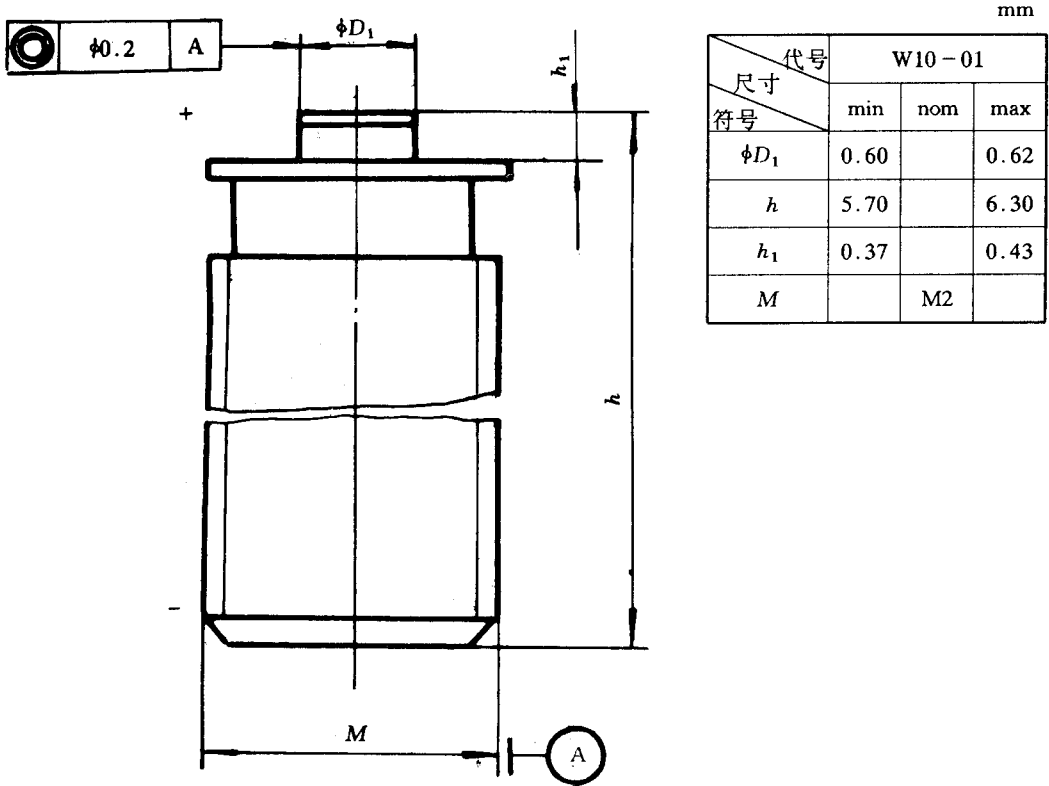


图 1 外形图

3.3 最大额定值和主要电特性

3.3.1 最大额定值

型号	工作电压 V_{OD} V	工作电流 I_{OD} mA	工作温度 T_{OD} ℃	贮存温度 T_{stg} ℃
2EY621 2EY622 2EY623	4.0	1000	-40~85	-65~175

3.3.2 主要电特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

特性和条件		输入功率 P_O mW	工作频率 f_{OD} GHz	工作电压 V_{OD} V	工作电流 I_{OD} mA	低场电阻 R_O Ω
型 号	2EY621	≥ 5	90~100	3~4	≤ 1000	0.5~2.0
	2EY622	≥ 15				
	2EY623	≥ 25				

3.4 电测试要求

电测试应符合 GB 6570 和本规范的规定。